

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 59-208756

(43)Date of publication of application : 27.11.1984

(51)Int.Cl.

H01L 23/12

H01L 21/56

H01L 23/48

(21)Application number : 58-083188

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing : 12.05.1983

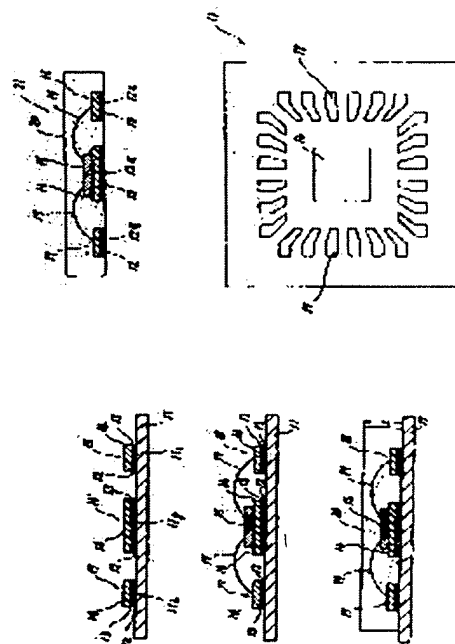
(72)Inventor : AKIYAMA KATSUHIKO
ONO TETSUO
KAJIYAMA YUJI

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching.

CONSTITUTION: Au plating 12 of $1\mu\text{m}$ thickness, Ni plating 13 of $1\mu\text{m}$ thickness and Au plating 14 of $3\mu\text{m}$ are laminated on an Fe substrate 11 of $35\mu\text{m}$ thickness. A semiconductor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness $t=1\text{mm}$. The Fe substrate is removed by etching with FeCl_3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In order to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—208756

⑬ Int. Cl.³

H 01 L 23/12

21/56

23/48

識別記号

庁内整理番号

7357—5F

7738—5F

7357—5F

⑭ 公開 昭和59年(1984)11月27日

発明の数 1

審査請求 未請求

(全 5 頁)

⑮ 半導体装置のパッケージの製造方法

⑯ 特 願 昭58—83188

⑰ 出 願 昭58(1983)5月12日

⑱ 発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑲ 発 明 者 小野鉄雄

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑳ 発 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

㉑ 出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

㉒ 代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

明 細 書

1. 発明の名称

半導体装置のパッケージの製造方法

2. 特許請求の範囲

選択エッチング可能な材料から成る基板上に半導体装置を配置し、接続用ワイヤを上記半導体装置に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部電極部を上記基板の外部電極接続部位に接続し、次いで上記基板上において上記半導体装置及び上記接続用ワイヤを一体に樹脂モールドし、しかる後上記樹脂をエッチング除去することを特徴とする半導体装置のパッケージの製造方法。

タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引出されているハンダ付け可能な電極をプリント基板の導体パタンに直接ハンダ付けして接続することにより実装を行うものである。

このチップキャリアタイプパッケージには、セラミックタイプとプラスチックタイプとがある。セラミックタイプはパッケージ自体が高価であるばかりでなく、プリント基板に直接ハンダ付けすると、温度サイクル時にセラミックスと上記ハンダ及び上記導体との間の熱膨張係数の差によって接続部にはがれやクラックが生じる恐れがあるという欠点を有している。一方、プラスチックタイ

特開昭59-208756(

するチップ(4)を載置し、ワイヤボンディング法により上記チップ(4)と上記電極(2)の一端とをAuの細線から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より液状のエポキシ樹脂を滴下させて硬化成形することによつて作る。

このパッケージ(1)において、チップ(4)は樹脂層(6)とプリント基板(3)とによつて固まれている。これらの樹脂層(6)及びプリント基板(3)の熱伝導性は共に大きいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果的に放散することができない。即ち、このパッケージ(1)は放散性が悪いという欠点を有している。また上記の液状のエポキシ樹脂を滴下する際に、微量の樹脂を一定量、しかも高速で滴下することが難しく、このためにパッケージ(1)はパッケージの製造の自動化に適していないという欠点を有している。

一方、上記のチップキャリアタイプパッケージとは異なるパッケージにテープキャリアタイプパッケージがある。このタイプのパッケージは従来のチップキャリアタイプパッケージよりもさらに

ることができる。なお上記外部電極部は上記接続用ワイヤ自体が兼ねていてもよいし、上記接続用ワイヤとは別に設けられかつ上記接続用ワイヤが接続されているものでもよい。

実施例

以下本発明に係る半導体装置のパッケージの製造方法の実施例につき図面を参照しながら説明する。

第2A図～第2D図は本発明の第1実施例による半導体装置のパッケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第2A図から工程順に説明する。

小形化できるという利点を有するが、チップと樹脂層によつて完全に覆われているため熱放散性良好でないこと、テープを用いているために十分な装設が必要である等の欠点を有している。

発明の目的

本発明は、上記の問題にかんがみ、熱放散性良好かつ信頼性の高い半導体装置のパッケージの製造方法を提供することを目的とする。

発明の概要

本発明に係る半導体装置のパッケージの製造方法は、選択エッチング可能な材料から成る基板上に半導体装置を載置し、接続用ワイヤを上記半導体装置に装設すると共にこの接続用ワイヤの另一端部を上記基板の外部電極接続部位に接続し、次いで上記基板上において上記半導体装置及び接続用ワイヤを一体に樹脂モールドし、その後上記基板をエッチング除去するようにしてこのようにすることによつて、熱放散性が良好かつ信頼性の高いリードレスタイプのパッケージを、簡便かつ安価な方法によつて自動的に製造

する図に示す。次に第2B図において、上記チップ載置部(2)にチップ(4)を載置した後、ワイヤボンディング法によつてこのチップ(4)と上記外部電極部(2)とをそれぞれAuの細線から成るワイヤ(5)で接続する。次に第2C図において、第2B図の裏面(1)の上に設けられた上記外部電極部(2)、チップ載置部(2)、チップ(4)及びワイヤ(5)を一体とするために、公知のトランスファ・モールド法(移注法)を用いて、エポキシから成る樹脂モールド層(6)を上記基板(3)上に形成する。なお本実施例においては、上記樹脂モールド層(6)の厚さを1

特開昭59-208756(3)

電極部10のAu層12の下面が外部電極面(12b)(12c)となり、またチップ設置部10のAu層12の下面が熱放散面(12a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージ10をプリント基板上に実装する場合には、第2D図に示す上記外部電極面(12b)(12c)をプリント基板上の導体パタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。

上述の第1実施例の熱放散面(12a)は、その動作時においてチップ10から発生する熱の放散面となつてゐる。金属の熱伝導率は非常に高いので、チップ10から発生する熱は金属製のチップ設置部10を外方に向かつて迅速に流れて、熱放散面(12a)から放散されることによつて効果的に除去される。しかし、より効果的にチップ10の発生熱を除去するためには、広い表面積を有する放熱フィンの一部を上記熱放散面(12a)に押し当てて空冷により熱を放散させるのが好ましい。

上述の第1実施例のパッケージ10は第2A図～第2D図に示すような簡単な工程によつて作るこ

完成させることができる。このように上記のエッチングによつてチップ設置部10及び外部電極部10の下部に上記アンダーカット部(11a)～(11f)が形成されるので、これらの部分に樹脂が回り込んで突出部(20a)～(20f)が形成される。従つてこれらの突出部(20a)～(20f)によつて上記チップ設置部10及び上記外部電極部10が下方から保持される構造となるので、上記チップ設置部10及び上記外部電極部10がパッケージ10の使用時に樹脂モールド層14から抜け出てしまうのを防止することができるという利点がある。さらにチップ設置部10及び外部電極部10が樹脂モールド層14の上面に公知のフォトレジストを塗布した後に所定のパターンニングを行う。次いで(のみを部分的にエッチングするエッチング液、例えば前述のFeCl₃溶液を用いて上記基板10の表面を僅かにエッチングすることによつて、上記基板10の表面にチップ設置部位(11g)及び外部電極部10の部位(11h)(11i)をそれぞれ形成する。上記フォトレジストを除去した後に第5B図において、第1実施例と同様に、上記チップ設置部位(11g)にハンダ層16を介してチップ10を接続した後、ワイヤボンディング法によつてこのチップ10と上記外部電極部10の部位(11h)(11i)とをそれぞれAg

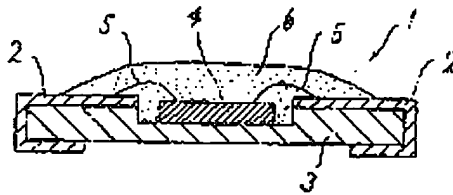
とができるばかりでなく、全ての製造工程に従来から用いられている装置を用いることができるので、テープキャリアタイプのパッケージにおいて必要な既述の特殊な装置が不要である。従つて、簡便かつ安価な方法によりパッケージ10を製造することができる。さらに上述の第1実施例では樹脂モールド層14を形成する方法としてトランスファ・モールド法(移送成形法)を用いている。この方法は信頼性の高い樹脂封止ができるばかりでなく、モールドの機械化、自動化が容易であるためにパッケージを自動的に製造できるという利点を有している。

なお上述の第1実施例において、第2A図に示す場合と同様にチップ設置部10及び外部電極部10を設けた後に、基板10の上面を前述のFeCl₃溶液を用いて僅かにエッチングすることにより、第4A図に示すようにチップ設置部10及び外部電極部10の下部の基板10にアンダーカット部(11a)～(11f)を形成し、次に第2B図～第2D図と同様な方法によつて第4B図に示すパッケージ10を

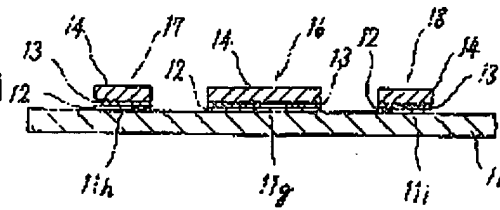
製造する。このようにして完成したパッケージ10は、上記基板10の上面に公知のフォトレジストを塗布した後に所定のパターンニングを行う。次いで(のみを部分的にエッチングするエッチング液、例えば前述のFeCl₃溶液を用いて上記基板10の表面を僅かにエッチングすることによつて、上記基板10の表面にチップ設置部位(11g)及び外部電極部10の部位(11h)(11i)をそれぞれ形成する。上記フォトレジストを除去した後に第5B図において、第1実施例と同様に、上記チップ設置部位(11g)にハンダ層16を介してチップ10を接続した後、ワイヤボンディング法によつてこのチップ10と上記外部電極部10の部位(11h)(11i)とをそれぞれAg

特開昭59-206756(5)

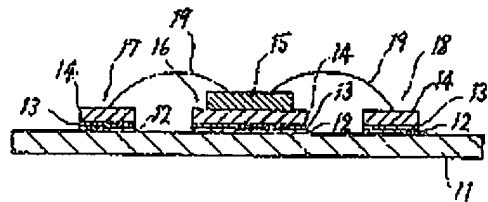
第 1 圖



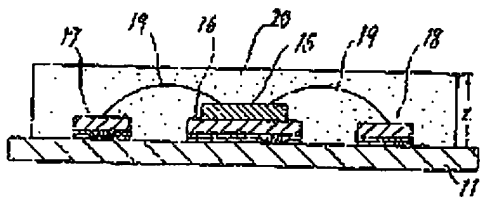
第 2 A 圖



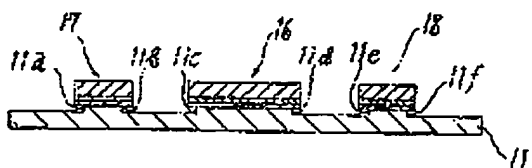
第 2 B 圖



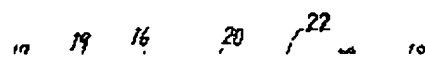
第 2 C 圖



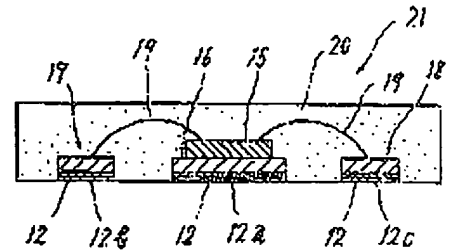
第 4 A 圖



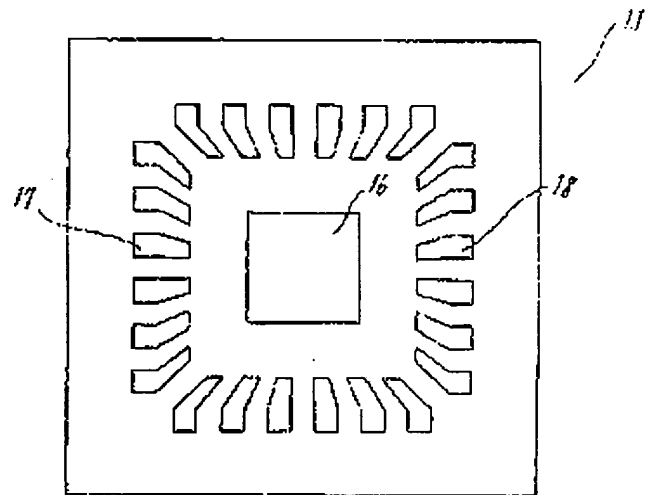
第 4 B 圖



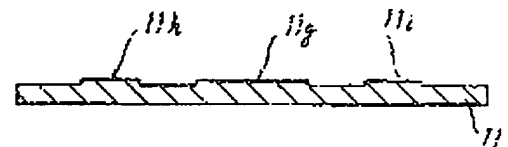
第 2 D 圖



第 3 圖



第 5 A 圖



第 5 B 圖

